

Cerințe parțial 2
Dispozitive electronice**Teorie:**

1. TEC-J: structură, funcționare, simbol
2. TEC-J: Caracteristici statice de drenă
3. TEC-J: caracteristica de transfer și transconductanța
4. Polarizarea TEC-J: autopolarizare și polarizare cu divizor rezistiv
5. TEC-MOS cu canal inițial: structură, regimurile de funcționare, simboluri
6. TEC-MOS cu canal indus: structură, polarizarea pe poartă, simboluri
7. TEC-MOS cu canal inițial: caracteristica de transfer, transconductanța
8. TEC-MOS cu canal indus: caracteristica de transfer și transconductanța
9. TEC-MOS cu canal inițial: polarizarea la zero
10. TEC-MOS cu canal indus: polarizare cu divizor de tensiune și cu reacție în drenă

Probleme:

O problemă cu

- TEC-J + TEC-MOS cu canal indus, *sau*
- TEC-MOS cu canal inițial + TEC-MOS cu canal indus

Partial examination 2 requirements
Electronic Devices**Theory:**

1. JFET: structure, basic operation, symbol
2. JFET: drain characteristic curves
3. JFET transfer characteristic and forward transconductance
4. JFET biasing: self-bias and voltage-divider bias
5. D-MOSFET: structure, operation modes, symbols
6. E-MOSFET: structure, operation, symbol

7. D-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance
8. E-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance
9. D-MOSFET: zero-bias

10. E-MOSFET: drain-feedback bias and voltage-divider bias

Exercises:

Only one exercise with

- JFET + E-MOS, *or*
- D-MOS + E-MOS